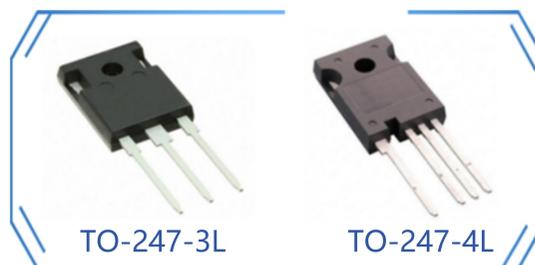


### IGBT高性能微沟槽单管产品——光储充新能源应用

#### 产品介绍

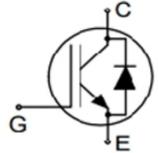
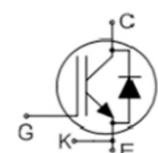
- 1、TO-247-3L/TO-247-4L等多种丰富封装;
- 2、650V 50A主流产品, 针对不同应用提供Si以及SiC混合封装产品;
- 3、产品主要用于光储充新能源应用, 采用先进沟槽设计技术, 满足电能转换系统对功率器件高效率的要求;
- 4、相关系列产品与市场主流产品完全pin to pin替代应用;
- 5、采用环保物料, 符合RoHS标准;



#### 产品特点

- 1、1.6um微沟槽设计, 优异的产品性能, 具备低Vce(sat)及快速开关特性;
- 2、细分中速S系列及高速H系列, 分别对应20-30Khz及30-40Khz的不同应用需求;
- 3、最高结温Tjmax=175°C, 高可靠性;

#### 电性参数

Part No.	Specification	Vcesat@25°C	Eoff@25°C	Diode	Package	Structure
DGW50N65CTS2A	50A/650V	1.45V	0.55mJ	Si diode	TO-247-3L	
DGW50N65CTH2A	50A/650V	1.70V	0.35mJ			
DGWC50N65CTS2A	50A/650V	1.45V	0.55mJ	Sic diode		
DGWC50N65CTH2A	50A/650V	1.70V	0.35mJ			
DGZ50N65CTS2A	50A/650V	1.45V	0.55mJ	Si diode	TO-247-4L	
DGZ50N65CTH2A	50A/650V	1.70V	0.35mJ			
DGZC50N65CTS2A	50A/650V	1.45V	0.55mJ	Sic diode		
DGZC50N65CTH2A	50A/650V	1.70V	0.35mJ			

更多产品详见官网

#### 应用领域



光伏



储能



充电桩